

P14-86-189

1986

С.А.Карамян

НЕОБРАТИМЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ЭФФЕКТА ТЕНЕЙ К КАНАЛИРОВАНИЮ ДЛЯ ИОНОВ, РАССЕЯННЫХ НА МОНОКРИСТАЛЛЕ Ge

Направлено в журнал "Известия АН СССР, серия физическая"

Hard Samphone Server as a server the Allert March and the Brit

Прохождение заряженных частиц в монокристаллах регулируется эффектами теней и каналирования, открытыми более 20-ти лет назад /1-3/. После выяснения основных характеристик этих эффектов на пучках протонов и d-частиц с энергией (0,I-I) МэВ/нуклон /4/ работы продолжались по линии исследования более тонких особенностей, а также постановки опытов с отрицательно заряженными частицами, релятивистскими частицами, малоэнергичными атомами и тяжелыми ионами.

Исследование эффекта теней при взаимодействии ускоренных тяжелых ионов в области энергии (0,6-8) МэВ/нуклон с монокристаллами металлов и полупроводников проводится в ЛЯР ОИЯИ, начиная с 1970 г. Согласно существующим представлениям ⁵ регистрация продуктов ядерных реакций на монокристаллической мишени в геометрии рассеяния на большой угол должна приводить к наблюдению эффекта теней, что и фиксировалось практически во всех экспериментах. Максимумы каналирования для частиц, выходящих из кристалла, должны наблюдаться только при прохождении изотропного потока частиц сквозь тонкую мишень, например, при нанесении радиоизотопного источника α -частиц на одну сторону кристалла и регистрации углового распределения частиц с другой стороны ⁶. В настоящей работе сообщается о наблюдении максимумов каналирования в угловом распределении ионов, рассеянных на большой угол, при облучении монокристаллаGe пучками ионов ²⁰Ne (IO4 MэB) и 40_{Ar} (205 МэВ).

Монокристаллическая мишень представляла собой отполированную пластину толщиной 0,5 мм детекторного германия ориентации (100). Использованы пучки циклотрона У-300, имевшие после прохождения коллиматора диаметр I мм, интенсивность не более 10^{10} с⁻¹ и угловой разброс < $\pm 1^{\circ}$. Ионы, рассеянные на мишени в геометрии на отражение, регистрировались в области углов $\theta_{L} = 32-80^{\circ}$ стеклянным трековым детектором (40 Аг) или полиэтилентерефталатом, закрытым 6-мкм Al-фольгой (20 Ne). В эксперименте с ионами 40 Аг стеклянный детектор регистрирует не только рассеянные ионы, но также ядра отдачи рассеяния (Ge) и продукты неупругих столкновений. Угловое распределение зарегистрированных в этом случае частиц представлено на рис. I. Видно, что наблюдается подъем выхода к малым углам и максимум в районе $\theta_L = =65-75^{\circ}$. В случае, если стекло 5-мкм Al-фольгой, ядра отдачи

> Оэьсянасчиный кнститут Васоных исследования



Рис. I Зависимость выхода от угла, измеренная стеклянным детектором, закрытым 6-мкм Аlфольгой (темные точки), и стеклом без фольги (светлые точки). Сплошные линии: I- вычисленный выход резерфордовского рассеяния ⁴⁰Ar при регистрации детектором с фольгой, 2- выход ядер отдачи Ge при резерфордовском рассеянии (детектор без фольги).



странственного распределения продуктов

реакции, зафиксированных стеклянным детектором (а), и результаты сканирования кристаллографических направлений: (III) при θ_{L} =35° (б); < III>, 58° (в); (OII), 72° (г). Обозначения на рис. 2а следующие: заштрихована область детектора, закрытая фольгой; жирная линияхорошо выраженные плоскостные тени; тонкая- слабые тени; двойная- максимумы каналирования; штриховая- изолинии угла θ_{L} ; стрелками даны направления сканирования.





Рис. 3. Профиль максимумов каналирования в угловом распределении ионов ²⁰Ne , рассеянных на монокристалле Ge , для следующих кристаллографических направлений: (IIĪ) при θ_{L} =52° (a); <III>, 58° (б); (OIĨ), 55° (в). Горизонтальным отрезком показано угловое разрешение.

упрутого и неупругого взаимодействия не попадают на детектор и остается только компонент распределения, монотонно убывающий с ростом угла. Этот факт, а также сравнение результатов измерений с рассчитанным выходом (на толстой мишени) продуктов упругого рассеяния доказывают, что в области углов $\theta_{\rm L} < 50^{\circ}$ главный вклад дают упруго-и неупругорассеянные ионы ${}^{40}{\rm Ar}$, а в области максимума в основном фиксируются тяжелые продукты реакции.

Рассмотрим теперь структуру углового распределения, связанную с кристаллографическими направлениями. Эта структура в виде сетки кристаллографических плоскостей наблюдена на детекторе визуально, так как большая плотность треков частиц делает поверхность стекла матовой. В области углов регистрации 75 > θ_{\downarrow} > 65° видна достаточно контрастная структура теневых минимумов, в интервале θ_{\downarrow} =60-50° тени становятся слабовыраженными, затем они исчезают, а при углах $\theta_{\downarrow} < 42^{\circ}$

3

изображение кристаллической структуры инвертируется, минимумы сменяются максимумами каналирования. Структура распределения схематически показана на рис. 2а. Количественные результаты сканирования плоскостных и осевых структур приведены на рис. 26-г. Видно, что ось <III>, ориентированная под углом 58° к пучку, дает теневой минимум, не более глубокий, чем плоскостной минимум (OIĪ) при $\theta_{L} = 72^{\circ}$. Это подтверждает ослабление эффекта теней при уменьшении угла. Для плоскости (IIĪ) при $\theta_{1} = 35^{\circ}$ выявляется очевидный максимум каналирования.

Наблюдаемую структуру рефлексов кристаллографических направлений (рис. 2) можно объяснить с учетом результатов рис. І следующим образом. Фиксируемые в интервале $\theta_{\perp} = 75-65^{\circ}$ ядра отдачи выходят из поверхностных слоев кристалла (в связи с небольшим пробегом) и показывают хорошо выраженный эффект теней. Рассеянные ионы, напротив, имеют довольно большой пробег и выходят, главным образом, из глубины кристалла в связи с ростом сечения рассеяния при торможении падающей частицы. Для ионов, вышедших из глубины кристалла, характер рефлексов определяется эффектом каналирования, что и наблюдается в интервале $\theta_{\perp} = 32-42^{\circ}$. В промежуточной области углов $\theta_{\perp} = 42-65^{\circ}$ структура слабо выражена в результате суперпозиции выходов ядер отдачи и рассеянных ионов.

Наблюдение максимумов каналирования для частиц, рассеянных в монокристаллической мишени, представляет собой неожиданный результат. Для проверки был сделан подобный эксперимент с ионами ²⁰ Ne . В этом случае частицы фиксировались пластиком, закрытым фольгой, которая задерживает тяжелые продукты реакции. В результате угловое распределение зарегистрированных частиц содержит только монотонно убывающий с ростом угла компонент, т. е. фиксируются упруго- и неупругорассеянные ионы. Кристаллографические направления проявляют себя в виде максимумов каналирования в интервале углов регистрации $\theta_{\perp} = 46-65^{\circ}$. Детектор перекрывал область θ_{\perp} от 46 до 74°, при $\theta_{\perp} > 65^{\circ}$ плотность треков зарегистрированных частиц была недостаточна для наблюдения структуры углового распределения. Результаты сканирования кристаллографических направлений даны на рис. 3, видны хорошо выраженные максимумы. Таким образом, однозначно доказано, что ионы ²⁰Ne и ⁴⁰Ar , рассеянные в глубине монокристалла Ge , на выходе из него приобретают структурные особенности распределения, связанные с эффектом каналирования.

Ионы, рассеянные в глубине кристалла, имеют исходное угловое распределение, определяемое эффектом теней, за счет деканалирования оно сменяется равномерным распределением по мере прохождения через кристалл, а затем в приповерхностной области частицы захватываются

в режим каналирования и выходят с соответствующим распределением. Захвату способствует увеличение критического угла каналирования Ψ_{r} при торможении частиц. Можно думать, что эффект каналирования является конечной сталией пвижения частии вблизи кристаллографических направлений, независимо от их предыстории попадания и движения в монокристаллической среде. Бесструктурное распределение. как в амороной среде. в монокристалле постигается, видимо, только на переходной ступени от преобладания эффекта теней к преобладанию каналирования. Если имеется равномерное распределение потока по пространственным координатам и углам в пределах элементарной ячейки, то каналирование будет преоблапать нал эффектом теней в связи с большим фазовым объемом по пространственным координатам. Наблюдаемый переход от теней к каналированию означает. что пля частиц. прошелших слой монокристалла немалой толшины, правило обратимости Линдхарда существенно нарушено. Выход в теневом минимуме х в геометрии прямой тени с ростом толщины слоя стремится к значению $\chi > I$, а выход каналирования в геометрии обратной тени – к $\lim_{n \to \infty} \zeta_{lim}$

Результаты настоящих экспериментов кроме качественных выводов позволяют оценить длину деканалирования и сделать некоторые заключения о механизме этого процесса. Действительно, трансформация эффекта теней в каналирование происходит после прохождения рассеянной частицей (40Ar) слоя + < 15 мкм Ge . Следовательно, уже после прохождения слоя 5-10 мкм исходное теневое распределение полностью разрушено процессами перерассеяния (деканалирования). Отсюда можно получить что сечение деканалирования ⁴⁰Аг в Ge составляет 60 × 3 10⁻²⁰ см² на атом при средней энергии ионов (50-IOO)МэВ (с учётом потерь энергии). Значение G_{G} того же порядка величины, что и сечение рассеяния на углы $\theta > \Psi_{c}$. Если за деканалирование ответственно рассеяние на ядрах, то приходим к выводу, что все 100% атомов в решетке занимают смещенное положение и дают вклад в деканалирование. Так как это нереально, то главным источником деканалирования следует признать взаимодействие с электронами. Для электронных процессов сечение декана-лирования $6_{\rm Q} \approx 10^{-21}$ см² на электрон довольно мало, а угол отклонения частицы $\theta > \psi_c^{\vartheta}$ относительно велик. Поэтому основное значение имеют, по-видимому, процессы многократного рассеяния на электронах и коллективного возбуждения атомов решетки.

Вообще говоря, существует возможность объяснять результаты без использования предположения о сильном деканалировании. Если частицы не рассеиваются средой кристалла, а только теряют энергию, то исходное теневое распределение сохраняется на выходе из кристалла. Угловая полуширина теневого минимума будет отвечать энергии частиц в точке

4

5

рассеяния $\Psi_1/\widehat{Z} \approx \Psi_C(E_1)$. Частицы в угловом интервале $\Psi_C(E_1) < \Psi < \Psi_C(E_2)$ (E_2 - энергия на выходе из кристалла) по мере торможения могут быть захвачены в режим каналирования в результате увеличения критического угла. Таким образом, может сформироваться угловое распределение выходящих частиц, состоящее из узкого теневого минимума, расположенного в центре более широкого максимума каналирования. В эксперименте теневой минимум не выявлен при имеющемся угловом разрешении и набранной статистике. Кроме того, против данного варианта интерпретации говорит также отсутствие широких максимумов в экспериментах по наблюдению эффекта теней при регистрации рассеянных частиц на пучке ионов с энергией 0,6 МэВ/нуклон и осколков деления.

Обнаружение максимумов каналирования для рассеянных ионов в настоящих экспериментах позволяет предложить новую интерпретацию результатов работы /7/, в которой зафиксировано значительное ослабление эффекта теней в области $\theta_L < 60^{\circ}$ при регистрации стеклянным детектором продуктов ядерного взаимодействия $^{20}N_{e}(104 \text{ MBB})$ + Ge. Теперь появляется возможность объяснить это не большим временем протекания реакции, а вкладом рассеянных ионов $^{20}N_{e}$. Регистрация ионов $^{20}N_{e}$ стеклом является околопороговым процессом и возможна только для ионов небольшой энергии $^{/8/}$.

Таким образом, при облучении монокристалла Ge пучками ионов с энергией 5 МэВ/нуклон зафиксированы максимумы каналирования в угловом распределении рассеянных частиц, что показывает значительную роль эффекта каналирования для частиц, выходящих из глубины кристалла. Эти факты требуют по-новому взглянуть на сам термин "деканалирование". До сих пор он использовался в традиционном значении, как разупорядочение регулярного, каналированного движения. Результаты измерений, однако, показывают, что в геометрии наблюдения прямой тени "деканалирование" разрушает эффект теней, а каналирование, напротив, создается кристаллом после того, как частица пройдет слой немалой толщины. Поэтому вместо деканалирования лучше употреблять слова "перерассеяние", "утловое разупорядочение".

Автор благодарен группе эксплуатации циклотрона У-300 ЛЯР ОИЯИ за получение пучков ионов, а также участникам научного семинара ЛЯР за полезное обсуждение интерпретации результатов.

ЛИТЕРАТУРА

I. Robinson M.T., Oen O.S. Phys. Rev., 1963, vol.132, p.2385.

2. Тулинов А.Ф. ДАН СССР, 1965, т. 162, с. 546.

Domeij B., Bjorkqvist K. Phys. Lett., 1965, vol. 14, p.127.
Channeling: Theory, Observation and Application . Wiley, N.Y.,1973.
Линдхард Й. УФН, 1969, т.99, с.249.

- 6. Скворцов В.В., Богдановская И.Н. Письма в ЖЭТФ, 1970, т.II, с.З.
- 7. Карамян С.А. Письма в ЖЭТФ, 1984, т.40, с.196.
- 8. Флейшер Р.Л., Прайс П.Б., Уокер Р.М. Треки заряженных частиц в твердых телах: принципы и приложения. Энергоиздат, М., 1981, часть І.

Рукопись поступила в издательский отдел 31 марта 1986 года.

	НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ?		Карамян С.А. Необратимый переход от эффекта тен	Р14-86-189 ей
Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, если они не были заказаны ранее.			к каналированию для ионов, рассеян	ных на монокристалле Ge
A17-81-758	Труды II Международного симпозиуна по избранным проблемам статистической механики. Дубна, 1981.	5 p. 40 ĸ.	При облучении монокристалла Ge пучками ионов ²⁰ Ne (104 МэВ)и ⁴⁰ Ar (205 МэВ) в пространственном распределении рассеянных частиц обнаружены максимумы каналирования в на- правлениях кристаллографических осей и плоскостей. Таким об- разом, зафиксирована трансформация эффекта теней в каналиро- вание для частиц, выходящих из глубины кристалла. Получена оценка длины деканалирования.	
P18-82-117	Труды IV совещания по использованию новых ядерно- физических методов для решения научно-технических м макоорнохозяйственных зарад Дубиа, 1981	3 D 80 F		
д2-82-568	т породнохозинственных задач. Дона, уст. Труды совещания по исследованиям в области релятивистской ядерной физики. Дубна, 1982.	1 р. 75 к.		
Д9-82-664	Труды совещания по коллективным методам ускорения. Дубна, 1982.	3 р. 30 к.	Работа выполнена в Лаборатори	и ядерных реакций ОИЯИ.
ДЗ,4-82-704	Труды IV Международной школы по нейтронной физике. Дубна, 1982.	5 p. 00 ĸ.		
д11-83-511	Труды совещания по системам и методам аналитических вычислений на ЭВМ и их применению в теоретической физике. Дубна, 1982.	2 р. 50 к.	Препринт Объединенного института ядернь	их исследований. Дубна 1986
Д7-83-644	Труды Международной школы-семинара по физике тяжелых ионов. Алушта, 1983.	6 р. 55 к	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Д2,13-83-689	Труды рабочего совещания по проблемам излучения и детектирования гравитационных волн. Дубна, 1983.	2 р. 00 к.		
Д13-84-63	Труды X! Международного симпозиума по ядерной электронике. Братислава Чехословакия, 1983.	4 p. 50 m		
Д2-84-366	Труды 7 Международного совещания по проблемам квантовой теории поля. Алушта, 1984.	4 p. 30	Перевод О.С.Виноградовой	
д1,2-84-599	Труды VII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1984.	5 p. 50 ;	Karamian S.A. Irrevisible Transformation of the	P14-86-189 Blocking
Д17-84-850	Труды Ш Международного симпозиуна по избранным пробленам статистической механики. Дубна,1984. /2 тома/	7 p. 75	A monocrystalline Ge target i	on Ge Single Crystal s irradiated by ²⁰ Ne
д10,11-84-818	Труды V Международного совещания по про- блеман математического моделирования, про- граммированию и математическим методам реше- ния физических задач. Дубна, 1983	3 p. 50	(104 MeV) and "Ar (205 MeV) ion beams, and the channeling maxima at the angular distribution of scattered particles are observed along crystallographic axis and plane direc- tions. Thus, the transformation of the blocking effect into	
	Труды IX Всесоюзного совещания по ускорит елян заряженных частиц. Дубна, 1984 /2 тона/	13 p.50	crystal is fixed. Dechanneling len	gth is estimated.
д4-85-851	Труды Международной школы по струхтуре ядра, Алушта, 1985.	3 p. 75	The investigation has been pe of Nuclear Reactions, JINR.	rformed at the Laboratory
Заказ	на упомянутые книги могут быть направлены по	адресу:		

Ŧ

101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79 Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1986